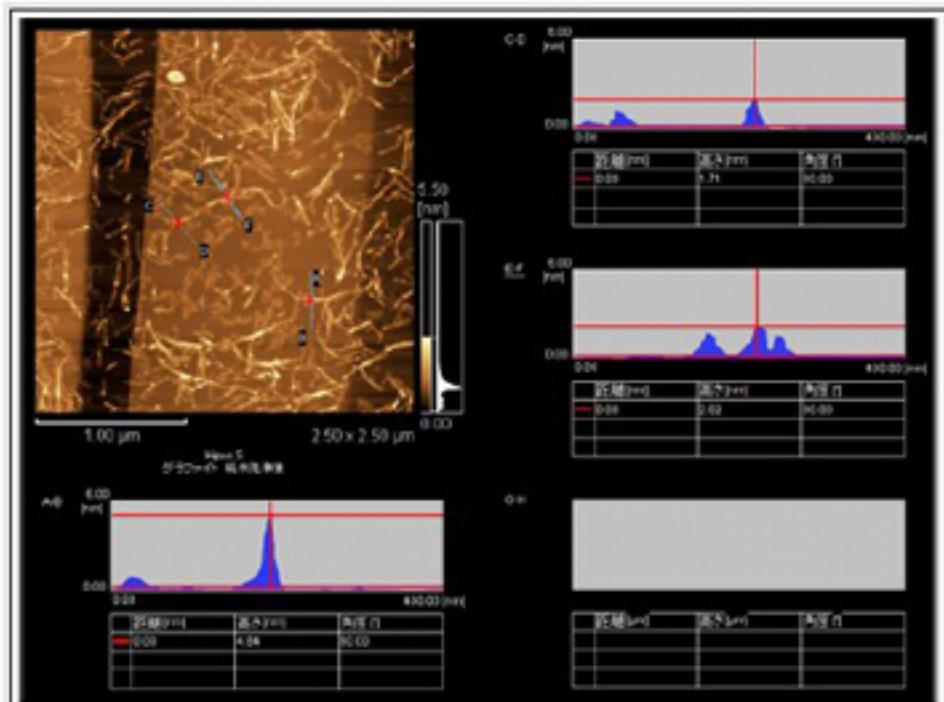
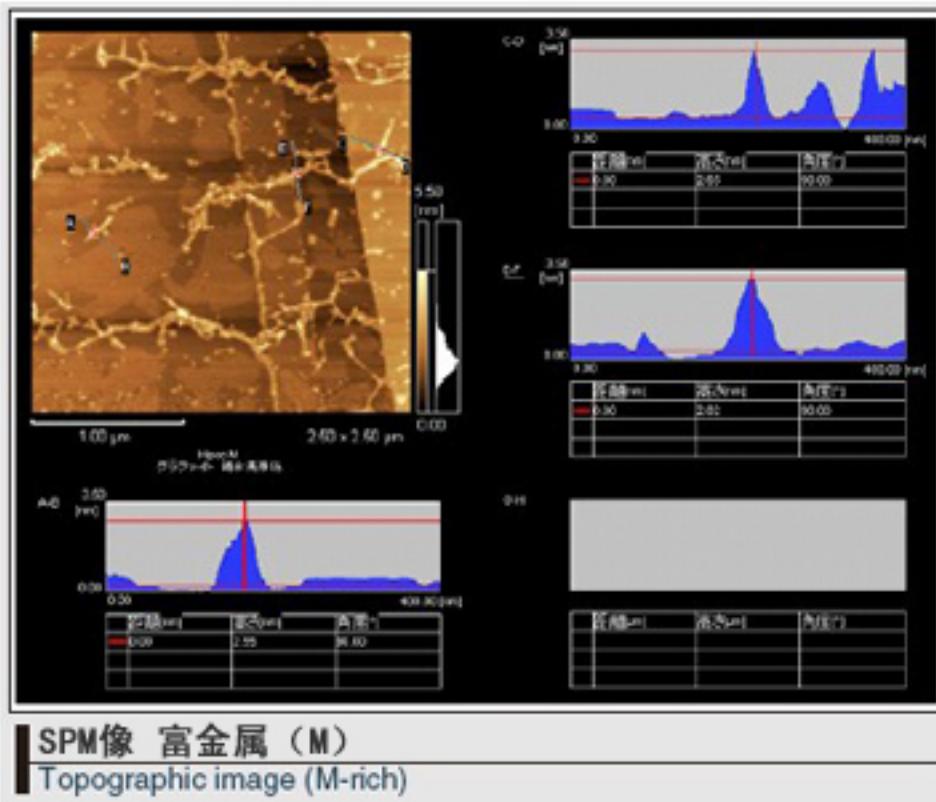


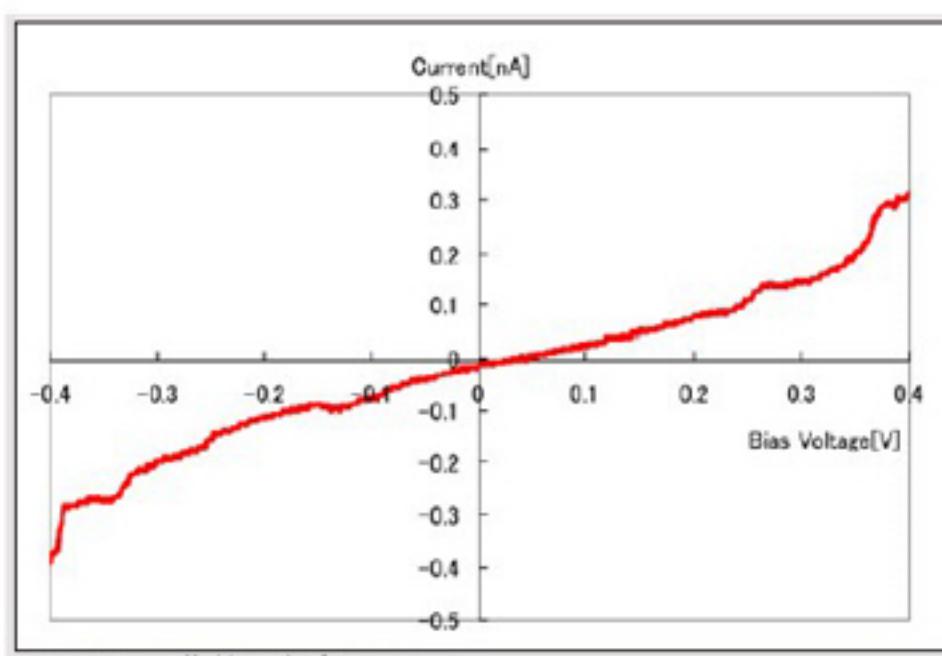
# SWCNT的M(富金属)和S(富半导体)样品的形态观察及I/V特性的测定

## Surface observation and I-V characteristic of single-wall carbon nanotube(SWCNT)

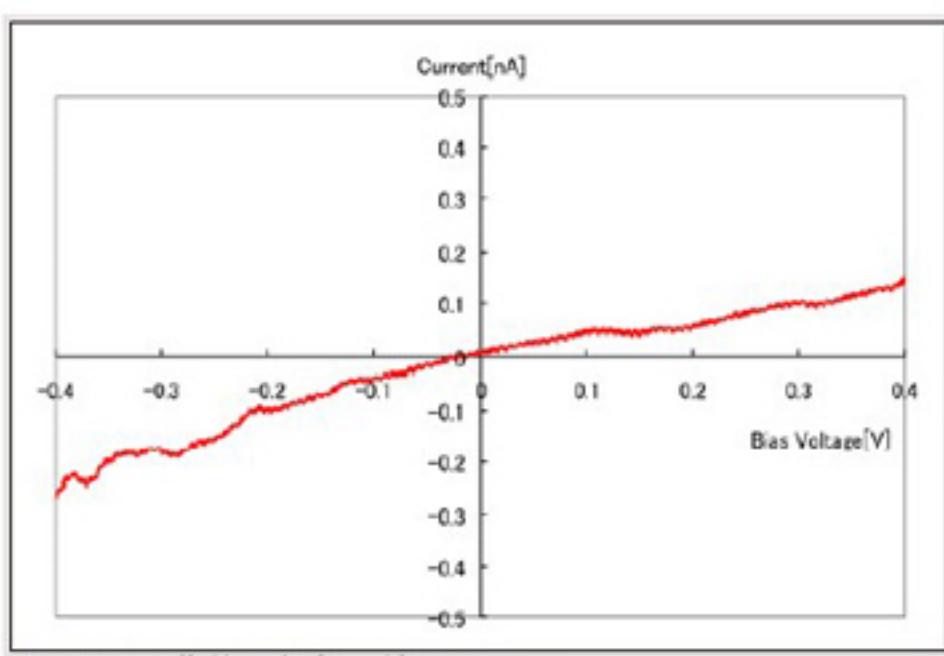


SPM像 富金属 (M)  
Topographic image (M-rich)

SPM像 富半导体 (S)  
Topographic image (S-rich)



I/V特性曲线 富金属 (M)  
I-V (current-voltage bias) characteristic curve(M)



I/V特性曲线 富半导体 (S)  
I-V characteristic curve(S)

上图分别为M样品、S样品的AFM形貌图及断面谱图。

下图为各CNT的I/V（电流/偏压）特性的测定例。

通过SPM进行电流测定，可以得到CNT电气特性。为保证传导性，样品基板采用HOPG。

样品 (Sample) : HiPco(Carbon Nanotechnology Inc.)

样品提供：名古屋大学大学院高等理学研究院 藤原研究室

Material supplied by Shinohara Laboratory,  
Graduate School of Science, Nagoya University